

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001 年 3 月 8 日 (08.03.2001)

PCT

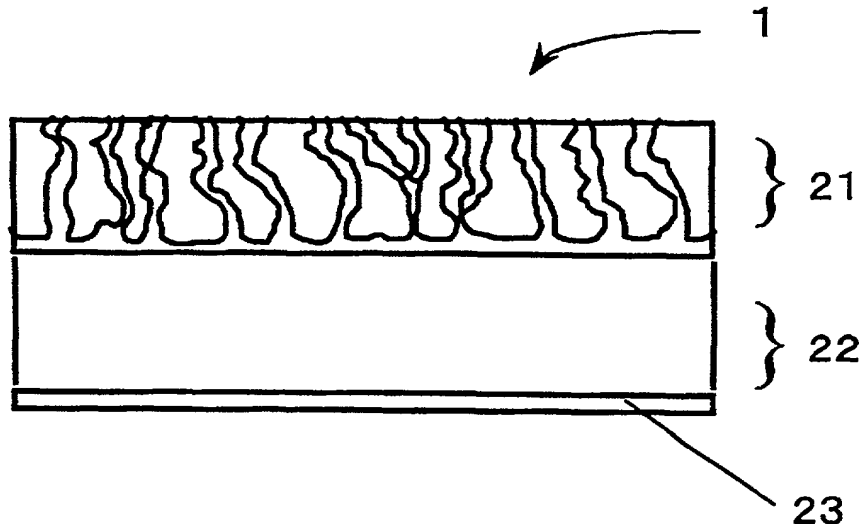
(10) 国際公開番号
WO 01/15860 A1

- (51) 国際特許分類⁷: B24B 37/00, H01L 21/304 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05595 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 誠 (KOBAYASHI, Makoto) [JP/JP]. 高松 広行 (TAKA-MATSU, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒961-8061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 150 番地 信越半導体株式会社 半導体白河研究所内 Fukushima (JP).
(22) 国際出願日: 2000 年 8 月 21 日 (21.08.2000)
(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 好宮 幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2 丁目 6 番 4 号 上野三生ビル 4F Tokyo (JP).
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願平 11/246243 1999 年 8 月 31 日 (31.08.1999) JP (81) 指定国 (国内): JP, KR, US.
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HANDOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1 丁目 4 番 2 号 Tokyo (JP). (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR POLISHING SEMICONDUCTOR WAFER

(54) 発明の名称: 半導体ウエーハ用研磨布及び研磨方法



(57) Abstract: A polishing cloth is used to polish a semiconductor wafer, particularly to give a mirror finish, without causing damage to the wafer surface. The polishing cloth has a zinc compound content of less than 200 ppm in terms of the weight of zinc in the polishing cloth, preferably less than 100 ppm, and more preferably no zinc compound is contained. The polishing cloth (1) includes a base layer (22), preferably of unwoven cloth, and a porous surface layer (21), preferably of polyurethane foam. The zinc compound content in the surface layer (21) is less than 100 ppm in terms of the weight of zinc in the surface layer (21).

[続葉有]

WO 01/15860 A1